

高周波プローブ

|Z|Probe シリーズ

- 長寿命（アルミニウム・金のパッドに対して 100 万回レベル）
- 独立したプローブ先端部構造により、最大 50 μ m のパッド段差を吸収
- オーバートラベル 200 μ m までの耐久性
- 完全な空気絶縁構造によって、最小の挿入損失と最大の反射損失を達成
- アルミニウム及び金パッド上で、低い接触抵抗と測定精度を達成
- 最大 10K ~ 400 $^{\circ}$ C 環境下に対応 ※option 対応
- 高周波プローブカードに対応
- 低価格を実現



プローブステーション

カスケード・マイクロテック社製の |Z| Probe シリーズは、プローブ先端部が MEMS 加工することにより、低損失、高精度再現性、高耐久性を実現した高周波測定用プローブです。Shield された同軸-プレーナ変換構造*により、ウェハーとのプレーナ~プレーナ・コンタクトを実現。反射損失を最小限に抑制し、高精度な測定を可能にします。また、G-S 間のアイソレート構造に空気絶縁方式を採用している為、高温（+300deg）での使用にも対応します。*特許取得済



新製品 アジャスタブル差動プローブ

Adjustable Left/ Right（差動測定用ワイドピッチ高周波プローブ、S-S 間の可変ピッチに対応）

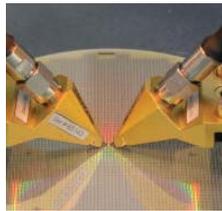
周波数	40GHz(GSG)	10GHz (GS / SG)
標準ピッチ	100, 125, 150, 200, 250 μ m※	100, 125, 150, 200, 250 μ m※
筐体		
■ Left	KLN	KLN
■ Right	KRN	KRN

株式会社 エーイーティー

<http://www.aetjapan.com>

|Z|Probe シリーズ 製品ラインナップ

|Z|Probe GS / SG



周波数	10GHz	NEW 20GHz
1 MX™テクノロジー	—	YES
標準ピッチ	550…1250 μm※	50…500 μm※
筐体		
■ スリムケース	K1N	K1N
■ スリムケース (高温 / 極低温対応型)	Y1N	Y1N
■ スタンダードケース	K3N	K3N
■ スタンダードケース (高温対応型)	Y3N	Y3N
■ Adjustable Left/Right	KRN/KLN	—

|Z|Probe GSG



周波数	40GHz	50GHz	NEW 67GHz
1 MX™テクノロジー	YES※※	YES	YES
標準ピッチ	50…1250 μm※	50…500 μm※	50…250 μm※
筐体			
■ スリムケース	K1N	K1N	V1N
■ スリムケース (高温 / 極低温対応型)	Y1N	Y1N	C1N
■ スタンダードケース	K3N	K3N	V3N
■ スタンダードケース (高温対応型)	Y3N	Y3N	C3N
■ Adjustable Left/Right	KRN/KLN		—

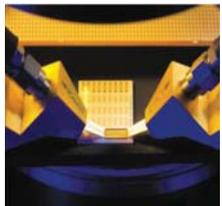
Dual |Z|Probe GSGSG GSSG / SGS

差動測定用高周波プローブ「デュアル」シリーズ、SGSGS・GSSG・SGS に対応



周波数	NEW 40GHz / 50GHz (GSGSG)	NEW 18GHz (GSSG / SGS)
1 MX™テクノロジー	YES	YES
標準ピッチ	100…500 μm※	100…500 μm※
筐体		
■ スタンダードケース	K3N / A3N	K3N
■ 高温 / 極低温対応型	Y3N / B3N	Y3N

|Z|Probe PCB GSG / GS / SG



周波数	4GHz (GS / SG)	NEW 20GHz z まで (GSG)
標準ピッチ	500, 650, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 μm (ご要望により、350…4500 μm もご提供可能)	
筐体		
■ スリムケース	P1S	
■ スタンダードケース	P3S	

※ スペックの詳細については、各カタログをご参照下さい。特注のピッチやフットプリントはお問い合わせください。

※※ 1MXテクノロジーは500μmピッチまでご提供可能です。

- |Z|Probeはカスケード・マイクロテック社の製品です。
- 本カタログに掲載された内容は、開発元における測定値であり、保証値ではありません。
- 無断転載・複写を禁じます。

©2010 AET Inc. All rights reserved. C100309-HA105-002